

21 世紀 COE プログラム「原子論的生産技術の創出拠点」第 2 回シンポジウム
精密工学会 超精密加工専門委員会 第 5 1 回研究会

『プラナリゼーションCMP プロセスに関わる最新技術動向』

協賛： 精密工学会 プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会

【日 時】 平成 1 5 年 1 2 月 1 2 日 (金)
13 : 00 ~ 17 : 00 (懇親会 17 : 00 ~)

【場 所】 虎ノ門パストラル
東京都港区虎ノ門 4-1-1 (TEL : 03-3432-7261)
地下鉄日比谷線神谷町 (出口 4a, 4b)

【趣 旨】 現在の超 LSI は、デバイスの微細化に加えて、配線や配線間の絶縁膜幅を微細にしなが配線を多層化することによって小型化と高速化が図られています。多層配線化にと
もなう各種リソグラフィ工程における平坦度への要求はますます厳しくなっており、各層で
の平坦化 (プラナリゼーション) プロセスは必要不可欠となっています。このような流れの
中で CMP (Chemical Mechanical Polishing) プロセスは、現在主流の技術として導入されて
いますが、欠陥や機械的ダメージの低減、高潔浄半導体プロセスへの適合性、種々の材料へ
の適用性などに関して、より高度な要求に対応できる技術の開発が望まれています。本研究
会では、超 LSI プロセスにおける CMP 技術の最新動向と、今後の実用化を目指した新しいプ
ラナリゼーションプロセスの開発、プロセス欠陥の評価技術に関して、第一線で研究・開発
に携わっておられる方々にご講演を頂きます。奮ってご参加ください。

【プログラム】

13:00 - 13:50 「 ULSI デバイスプロセスにおける CMP 技術の動向と新しいベルジャー型
CMP 装置」
埼玉大学 教育学部 土肥 俊郎 氏

13:50 - 14:40 「 先端 BEOL 技術の動向と電解複合型 CMP の可能性」
ソニー(株)マイクロシステムズネットワークカンパニー
佐藤 修三 氏

14:40 - 15:00 休憩 (コーヒーブレイク)

15:00 - 15:50 「 超純水電解加工 (超純水のみによる電気化学的加工方法) の
Cu ダマシン平坦化プロセスへの適用開発」
(株) 荏原製作所 精密・電子事業本部
野路 郁太郎 氏

15:50 - 16:40 「 CMP プロセスにおける欠陥とその評価技術」
ケーエルエー・テンコール(株) サポートオペレーション本部
泉 宏比古 氏

17:00 - 懇親会

【参加費】 無料

参加ご希望の方は、所属と氏名を 1 2 月 1 0 日までに、下記宛メールでご連絡ください。
21 世紀 COE 「原子論的生産技術の創出拠点」事務局 21coe@upst.eng.osaka-u.ac.jp